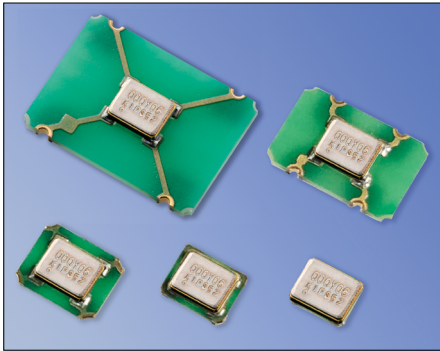




### Clock Z系列

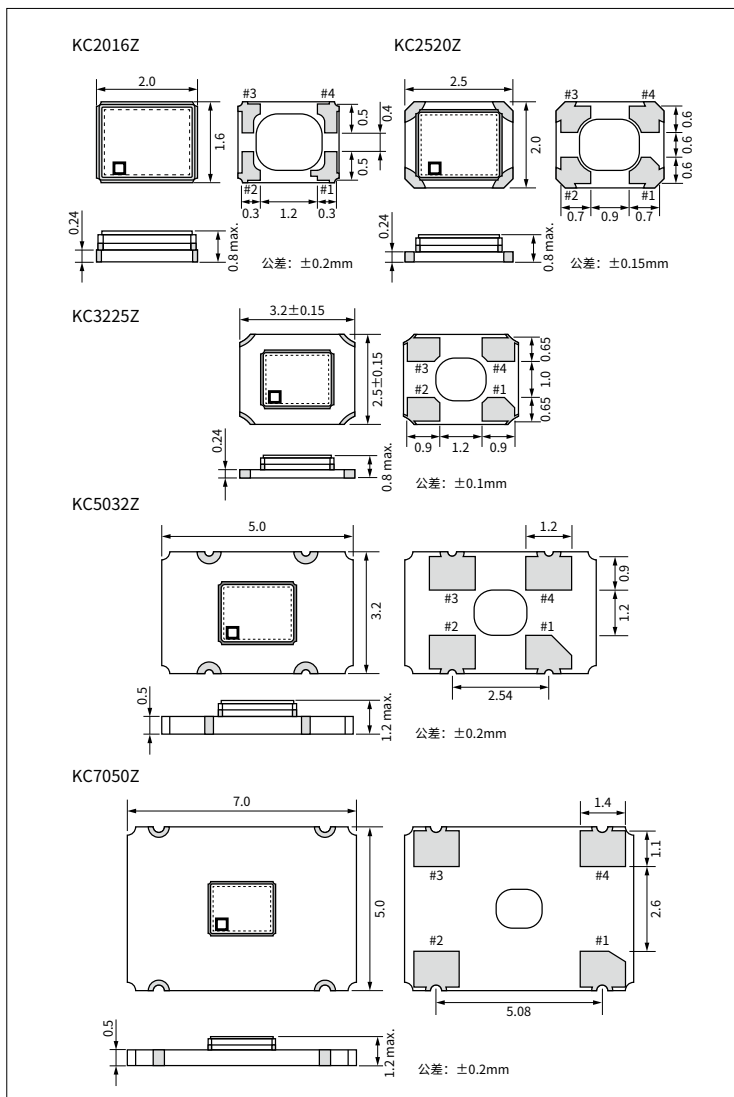
CMOS/ 1.8V、2.5V、3.3V/ 2.0×1.6、2.5×2.0、3.2×2.5、5.0×3.2、7.0×5.0mm



RoHS指令对应产品

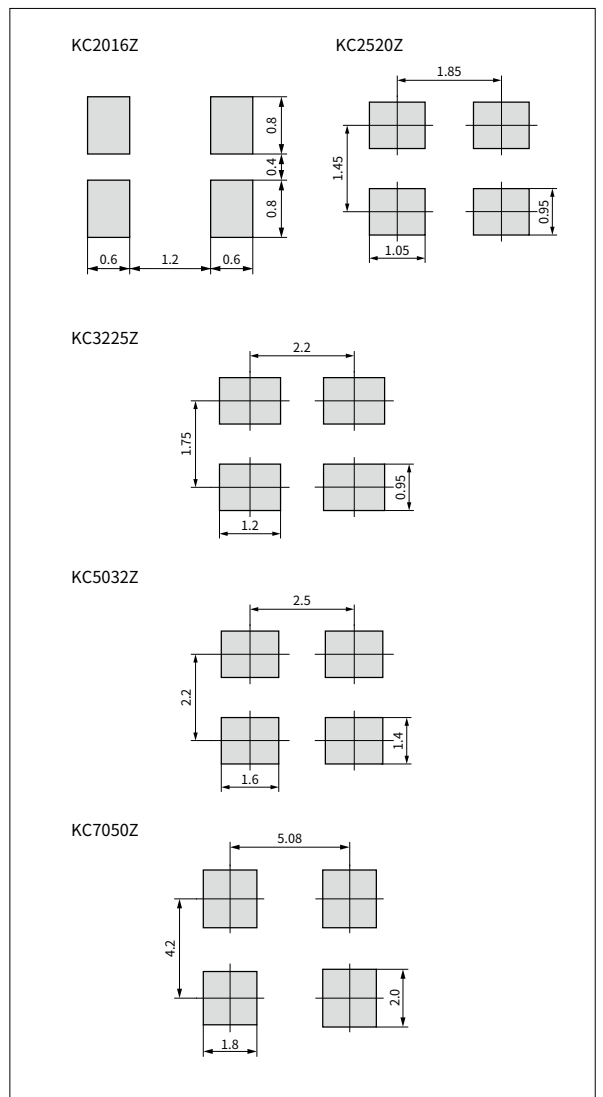
### 外形尺寸

(单位: mm)



### 推荐焊盘图案

(单位: mm)



时钟晶体振荡器

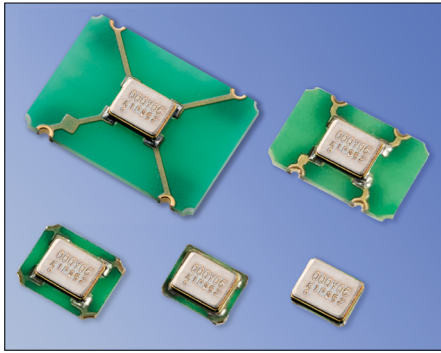
焊盘布局	
#1	Stand-by Function
#2	Case GND
#3	Output
#4	Vcc

Stand-by Function	
Pad1	Pad3 (Output)
Open	Active
"H" Level	Active
"L" Level	High Z (振荡停止)



Clock Z系列“X”类型(短交期类型)

CMOS/ 1.8V、2.5V、3.3V/ 2.0×1.6、2.5×2.0、3.2×2.5、5.0×3.2、7.0×5.0mm



RoHS指令对应产品

■特点

- 可对应频率 0.5~170MHz
- CMOS输出
- 可对应短交期
- 可对应高温(125°C)

■用途

- 消费类电子产品、网络、工业设备、娱乐
- 频率容差(Overall)

容差	工作温度范围	备注
代号 × 10 <sup>-6</sup>	(°C)	
S ± 30	-10 ~ +70	其他稳定度, 敬请咨询。
U ± 25		
W ± 20		
G ± 50		
H ± 30		
J ± 25	-40 ~ +85	
K ± 20		
L ± 15		
6 ± 50		
5 ± 30	-40 ~ +105	
X ± 100		
Z ± 50	-40 ~ +125	
9 ± 30		

■型号表示方法

KC□□□□Z 25.0000 C 1 □ X 00  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①系列名称

KC2016Z	2016型号	KC2520Z	2520型号
KC3225Z	3225型号	KC5032Z	5032型号
KC7050Z	7050型号		

②输出频率(25.0000: 25MHz)

③输出形式(C: CMOS)

④电源电压(1: 可以用于这些规格 1.8V/ 2.5V/ 3.3V)

⑤频率容差(参见左表)

⑥对称/INH功能

X	45/ 55%
---	---------

⑦个别规格(产品目录以00标示)

包装方式 载带包装

KC7050Z/ KC5032Z	1000个/卷盘
KC3225Z/ KC2520Z/ KC2016Z	2000个/卷盘

■规格

项 目	记 号	条 件	Min.	Max.	单 位	
输出频率范围	f <sub>o</sub>		0.5	170	MHz	
频率容差	f <sub>tol</sub>	起始偏差、工作温度范围内的温度特性、电源电压变化、负载容量变化、长期变化(1年@25°C)、包括振动和冲击	参见频率容差表			
储存温度范围	T <sub>stg</sub>		-55	150	°C	
工作温度范围	T <sub>use</sub>		参见频率容差表			
最大的额定电压	—		-0.3	4.5	V	
电源电压	V <sub>cc</sub>		1.71	3.63	V	
电流消耗 (Noload/ 1.71≤V <sub>cc</sub> ≤2.25)	I <sub>cc</sub>	0.5≤f <sub>o</sub> <5MHz	—	5.2	mA	
		5≤f <sub>o</sub> <15MHz	—	5.8		
		15≤f <sub>o</sub> <30MHz	—	6.2		
		30≤f <sub>o</sub> <50MHz	—	6.8		
		50≤f <sub>o</sub> ≤60MHz	—	6.8		
		60<f <sub>o</sub> <75MHz	—	9		
		75≤f <sub>o</sub> <105MHz	—	10		
		105≤f <sub>o</sub> <130MHz	—	10.5		
		130≤f <sub>o</sub> <160MHz	—	11.5		
		160≤f <sub>o</sub> ≤170MHz	—	12.5		
电流消耗 (Noload/ 2.25<V <sub>cc</sub> ≤2.8)	I <sub>cc</sub>	0.5≤f <sub>o</sub> <5MHz	—	5.5	mA	
		5≤f <sub>o</sub> <15MHz	—	6		
		15≤f <sub>o</sub> <30MHz	—	6.5		
		30≤f <sub>o</sub> <50MHz	—	7.2		
		50≤f <sub>o</sub> ≤60MHz	—	7.4		
		60<f <sub>o</sub> <75MHz	—	10		
		75≤f <sub>o</sub> <105MHz	—	11.5		
		105≤f <sub>o</sub> <130MHz	—	12.5		
		130≤f <sub>o</sub> <160MHz	—	14		
		160≤f <sub>o</sub> ≤170MHz	—	15		
电流消耗 (Noload/ 2.8<V <sub>cc</sub> ≤3.63)	I <sub>cc</sub>	0.5≤f <sub>o</sub> <5MHz	—	5.8	mA	
		5≤f <sub>o</sub> <15MHz	—	6.5		
		15≤f <sub>o</sub> <30MHz	—	7.3		
		30≤f <sub>o</sub> <50MHz	—	8		
		50≤f <sub>o</sub> ≤60MHz	—	8.5		
		60<f <sub>o</sub> <75MHz	—	12.5		
		75≤f <sub>o</sub> <105MHz	—	14.5		
		105≤f <sub>o</sub> <130MHz	—	15.5		
		130≤f <sub>o</sub> <160MHz	—	18		
		160≤f <sub>o</sub> ≤170MHz	—	19.5		
待机时的电流消耗	I <sub>std</sub>		—	5	μA	
波形对称	SYM	@50% V <sub>cc</sub>	45	55	%	
上升/下降时间 (20%~80% 输出电平)	Tr/ Tf	0.5≤f <sub>o</sub> ≤60MHz	Loaded/ 1.71≤V <sub>cc</sub> ≤2.25	—	4	ns
			Loaded/ 2.25<V <sub>cc</sub> ≤2.8	—	3	
			Loaded/ 2.8<V <sub>cc</sub> ≤3.63	—	2.5	
		60<f <sub>o</sub> ≤170MHz	Loaded/ 1.71≤V <sub>cc</sub> ≤2.25	—	1.5	
			Loaded/ 2.25<V <sub>cc</sub> ≤2.8	—	1.3	
			Loaded/ 2.8<V <sub>cc</sub> ≤3.63	—	1	
L电平输出电压	V <sub>oL</sub>	I <sub>oL</sub> = 5mA	—	10% V <sub>cc</sub>	V	
H电平输出电压	V <sub>oH</sub>	I <sub>oH</sub> = -5mA	90% V <sub>cc</sub>	—	V	
输出负载条件(CMOS)	L CMOS		—	15	pF	
L电平输入电压	V <sub>iL</sub>		—	30% V <sub>cc</sub>	V	
H电平输入电压	V <sub>iH</sub>		70% V <sub>cc</sub>	—	V	
禁用时间	t <sub>dis</sub>		—	200	ns	
启用时间	t <sub>ena</sub>		—	5	ms	
振荡启动时间	t <sub>str</sub>	最小动作电压为0sec.	—	5	ms	

最大负载时, 没有指定条件的电气特性为在工作温度范围内。